

Реєстраційна картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний реєстраційний номер: 0101U006543

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 25-09-2001

II. Підстава для проведення робіт

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір з МОН, іншими центральними органами виконавчої влади

Напрямок фінансування:

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК):

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 50 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Міністерство промислової політики України

Код за ЄДРПОУ: 00013942

Місцезнаходження: , м. Київ, Київ, 03035, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 246-33-20, 245-62-09

IV. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-виробниче підприємство "Електрон-Карат"-дочірнє підприємство ПрАТ "Концерн-Електрон"

Код за ЄДРПОУ: 23273999

Місцезнаходження: вул. Стрийська, 202, м. Львів, Львівська обл., 79031, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2631065

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технології створення напівпровідникових лазерних структур на основі з'єднань АЗВ5 для високоефективних систем зчитування та запису інформації

Назва роботи англійською:

Development of technology of semiconductors laser structure creation on the base of AZB5 compound for high efficiency system of reading and receiving of information

Мета роботи українською:

Основною метою роботи є розробка технологій одержання методом рідинно-фазної епітаксії активних середовищ для напівпровідникових та мікрочіпових лазерів

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка

Очікувані результати: Будуть розроблені технології виготовлення напівпровідникових та мікрочіпових лазерних структур з наступними параметрами: Довжина хвилі генерації, мкм- 1.064; Товщина монокристалічної підкладки AlG:Nd, мкм- 500-1000; Товщина шару AlG:Cr4+, мкм-50-200; Концентрація іонів Cr4+, см-3- 10^{17} - 10^{19} ; Діаметр структури, мм-20-50. Для напівпровідникових структур: Розмір, мм2-15x20; Товщина активного шару, мкм-0,02-0,01; Густина порогового струму активного елемента, А/см2-750; Кількість шарів, шт.-6; Довжина хвилі генерації, мкм-0,7-0,85.

Галузь застосування:

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Іжнін І.І.

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розробка технології створення напівпровідникових лазерних структур на основі з'єднань АЗВ5 для високоефективних систем зчитування та запису інформації.

Початок етапу: 04.2001

Закінчення етапу: 12.2001

Вид звітнього документа: Остаточний звіт

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ

Індекс УДК: 002.5:004, 621.315.55:538.945:537.311:002.5

Коди тематичних рубрик: 20.53.19

IX. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Ваків М.М.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.